

物理電子システム創造専攻

平成20年度3月修了予定者修士論文発表会プログラム

発表時間:25分=発表15分+質疑10分

2月3日(火) B会場(すずかけホール第2集会室)9:00~15:40

開始	氏名	指導教員	発表題目	審査員	備考
9:00	大岩 朝洋	徳光	In-Ga-Zn-Oをチャネルに用いた高・強誘電体ゲート薄膜トランジスタに関する研究	徳光、石原、筒井	
9:25	近藤 洋平	徳光	高誘電率材料をゲート絶縁膜に用いた酸化物チャネル薄膜トランジスタの作製	徳光、石原、筒井	
9:50	守谷 仁	徳光	有機金属気相成長法により形成したAl ₂ O ₃ をゲート絶縁膜とする4H-SiC MOSFETに関する研究	徳光、岩井、筒井	
10:15	岡本 晃一	岩井	Performance Improvement of Sub-1nm EOT MOSFET -Selection of Metal/high-k Materials for Effective Oxygen Control-	岩井、筒井、杉井	
10:40	休憩				
10:45	上村 英之	岩井	Nickel silicide contact for Silicon nanowire FET	岩井、筒井、杉井	
11:10	藤澤 宏樹	岩井	Electrical Characterization of W/HfO ₂ MOSFETs with La ₂ O ₃ Incorporation	岩井、筒井、杉井	
11:35	野口 浩平	岩井	A Study of Schottky Barrier Height Modulation by Metal Insertion and Its Application to SB-MOSFETs	岩井、筒井、杉井	
12:00	休憩				
13:00	日野 雅文	岩井	New Stress Inducing Technique for UTBSOI	杉井、岩井、筒井	
13:25	幸田 みゆき	岩井	A Guideline for Material Design of Gate Oxide in Further Scaled MOSFET -Improvement of electrical properties by CeO ₂ /La ₂ O ₃ stack structure-	岩井、石原、筒井、杉井、徳光	進学
13:50	田中 敬人	石原	有機半導体を用いた強誘電体ゲートトランジスタの研究	石原、徳光、大見	
14:15	王 冬珏	石原	Sr ₂ (Ta, Nb)O ₇ を強誘電体層に用いたMFISデバイスの研究	石原、筒井、徳光	
14:40	休憩				
14:50	近藤 佑美	石原	2T型強誘電体メモリの動作特性評価に関する研究	石原、岩井、徳光	
15:15	金正桓	石原	SrRuO ₃ /Pt(111)とPt(111)電極上に高周波スパッタ法を用いて形成したBiFeO ₃ 膜の特性評価	石原、岩井、筒井、徳光、大見	進学

2月4日(水) B会場(すずかけホール第2集会室)9:30~15:40

開始	氏名	指導教員	発表題目	審査員	備考
9:30	佐渡島 進	益	スケーラブル広帯域RF CMOS増幅回路に関する研究	益、浅田、大見	
9:55	植山 寛之	中山・益	トランジスタ特性ばらつきの測定手法と統計学的考察	中山、益、岩井	
10:20	宮下 一哉	益	超高速チップ内/チップ間高密度信号伝送に関する研究	益、岩井、植之原	
10:45	峰山 亜希子	益	高速低電力CMOSデータ多重/分離回路に関する研究	益、石原、徳光	
11:10	小林 由佳	益	スケーラブル広帯域RF CMOSシンセサイザに関する研究	益、石原、筒井	
11:35	休憩				
13:00	モハマド アヌア	大見	ECRスパッタ法によるHfN/HfO _x N _y 積層構造の形成に関する研究	大見、石原、徳光	
13:25	須田 雄一郎	大見	極薄HfN層導入によるPtSi/HfON界面制御に関する研究	大見、岩井、筒井	
13:50	酒井 一憲	筒井	反復剥離法による微細立体構造への不純物ドーピングプロファイルの評価	筒井、岩井、大見	
14:15	中川 恭成	筒井	高濃度極浅ドープ層におけるN形不純物活性化状態とその深さ方向分布の評価	筒井、岩井、徳光	
14:40	休憩				
14:50	横手 義智	筒井	Niシリサイドバッファ層を用いたSi基板上弗化物超薄膜ヘテロ構造の成長	筒井、石原、渡辺	
15:15	三浦 圭	筒井	集積型弗化物共鳴トンネル素子に向けたSi表面の低温清浄化法	筒井、石原、渡辺	